

广东协铨微电子科技有限公司

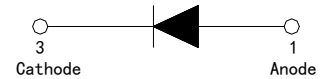
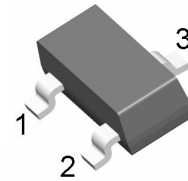
Schottky Diode 肖特基二极管

XCBAS70

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特点

Low forward voltage 低正向压降
High breakdown voltage 高反向击穿电压
Ultra high-speed switching 超高速开关应用
Protection circuits 保护电路应用

SOT-23



PIN ASSIGNMENT 引脚说明

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-23	
A	1	Anode
NC	2	—
C	3	Cathode

MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Reverse Voltage 反向电压	V _R	70	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	I _F	70	mAdc
Peak Forward Surge Current 正向最大浪涌电流 t≤1s	I _{FM(surge)}	100	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) T _A =25℃	P _D	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) T _A =25℃ 总耗散功率 氧化铝衬底	P _D	300	mW
Junction and Storage Temperature结温和储存温度	T _J , T _{stg}	150, -55 ~ 150	℃

- FR-5=1.0×0.75×0.062in,printed-circuit board.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in,99.5%alumina

DEVICE MARKING 打标

XCBAS70=73

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

(T_A=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25℃)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流	I _R	V _R =50Vdc	—	—	0.1	μA
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	V _(BR)	I _{BR} =10 μ Adc	70	—	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压	V _F	I _F =1mAdc	—	—	410	mV
		I _F =10mAdc	—	—	750	
		I _F =15mAdc	—	—	1000	
Total Capacitance 电容	C _T	V _R =0V,f=1.0MHz	—	—	2.0	pF